

H10H 電位障壁を有する，無機発光半導体装置 [2 0 2 5 . 0 1]

注

1. このサブクラスは可視，赤外 [I R] または紫外 [U V] の光を発する，無機発光半導体装置を包含する。これは発光ダイオード [L E D] およびスーパーluminescentダイオード [S L D] を含む。
2. このサブクラスは半導体レーザーを包含しない，半導体レーザーはグループ H 0 1 S 5 / 0 0 に包含される。
3. このサブクラスでは，セクション C の注 (3) の周期表中に示された I ~ V I I I 族の周期系が用いられる。[2 0 2 5 . 0 1]

- 20/00 電位障壁を有する個々の無機発光半導体装置，例．発光ダイオード [L E D] [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/01 ・製造または処理 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/80 ・構造的細部 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/81 ・本体 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/811 ・量子効果を奏する構造または超格子を有するもの，例．トンネル接合 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/812 ・発光領域内にあるもの，例．量子閉じ込め構造を有するもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/813 ・複数の発光領域を有するもの，例．多接合 L E D または本体の内部にフォトルミネセント領域を有する発光装置 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/814 ・反射手段を有するもの，例．半導体ブラッグ反射鏡 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/815 ・応力緩和構造を有するもの，例．バッファ層 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/816 ・電流制御構造を有するもの，例．高濃度ドープ半導体層，電流ブロック構造 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/817 ・結晶構造または結晶方位に特徴のあるもの，例．多結晶，アモルファスまたはポーラス [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/818 ・発光領域内にあるもの [2 0 2 5 . 0 1]

注

このグループに分類する場合，発光領域の化学組成を特定するために，グループ H 1 0 H 2 0 / 8 2 2 にも分類する。[2 0 2 5 . 0 1]

- 20/819 ・その形状に特徴のあるもの，例．湾曲または面取りされた基板 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/82 ・粗面化された表面，例．エピタキシャル層の界面にあるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/821 ・発光領域にあるもの，例．非プレーナー接合 [2 0 2 5 . 0 1]

20/822 ・発光領域の材料 [2 0 2 5 . 0 1]

注
このグループに分類する場合，ドーパントまたは他の不純物に関係なく，材料の成分を考慮する。[2 0 2 5 . 0 1]

- 20/823 ・ I I - V I 族の材料のみからなるもの，例．Z n O [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/824 ・ I I I - V 族の材料のみからなるもの，例．G a P [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/825 ・窒素を含むもの，例．G a N [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/826 ・ I V 族の材料のみからなるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/83 ・電極 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/831 ・その形状に特徴のあるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/832 ・その材料に特徴のあるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/833 ・透明材料 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/84 ・コーティング，例．パッシベーション層または反射防止コーティング [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/841 ・反射コーティング，例．誘電体ブラッグ反射鏡 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/85 ・パッケージ [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/851 ・波長変換手段 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/852 ・封緘 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/853 ・その形状に特徴のあるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/854 ・その材料に特徴のあるもの，例．エポキシ樹脂またはシリコン樹脂 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/855 ・光の形状を形成する手段，例．レンズ [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/856 ・反射手段 [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/857 ・相互接続，例．リードフレーム，ボンドワイヤーまたは溶剤ボール [2 0 2 5 . 0 1]
- 20/858 ・放熱または冷却のための手段 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/00 グループ H 1 0 H 2 0 / 0 0 に包含される，少なくとも 1 つの発光半導体素子を備える，集積装置または複数の装置の組立体 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/01 ・製造または処理 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/02 ・ピックアッププレース工程を用いるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/03 ・ L E D のマストランスファーを用いるもの，例．液状懸濁物を用いるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/10 ・グループ H 1 0 H 2 0 / 0 0 に包含される，少なくとも 1 つの発光半導体構成部品を備える，集積装置（アクティブマトリクス型 L E D ディスプレイ H 1 0 H 2

H 1 0 H

- 29/14 9 / 3 0) [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/20 ・ ・ 複数の発光半導体構成部品を備えるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/24 ・ グループ H 1 0 H 2 0 / 0 0 に含まれる , 少なくとも 1 つの発光半導体装置を備える , 複数の装置の組立体 (アクティブマトリクス型 L E D ディスプレイ H 1 0 H 2 9 / 3 0) [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/30 ・ ・ 複数の発光半導体装置を備えるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/30 ・ アクティブマトリクス型 L E D ディスプレイ [2 0 2 5 . 0 1]

注

このグループは , その発明の重点が L E D , L E D と密接に関連する層または L E D と密接に関連する構造的細部であるアクティブマトリクス型ディスプレイを包含する , 例 . L E D 間またはその封緘の間の相互接続 [2 0 2 5 . 0 1]

- 29/32 ・ ・ 副画素の内部の素子の幾何学的形状または配置に特徴のあるもの , 例 . R G B 副画素の内部のトランジスタの配置 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/34 ・ ・ 画素の内部の副画素の幾何学的形状または配置に特徴のあるもの , 例 . R G B 副画素の相対的配置 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/37 ・ ・ 画素を定義するための構造 , 例 . L E D 間の隔壁 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/39 ・ ・ 駆動トランジスタへの画素電極の接続 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/41 ・ ・ 駆動トランジスタと L E D 間に形成される絶縁層 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/45 ・ ・ それぞれ上にアクティブ素子を有する 2 つの基板からなるもの , 例 . 異なる基板上に存在する L E D アレイと駆動回路からなるディスプレイ [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/49 ・ ・ 相互接続 , 例 . 配線または端子 (駆動トランジスタへの画素電極の接続 H 1 0 H 2 9 / 3 9) [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/80 ・ 構造的細部 [2 0 2 5 . 0 1]

注

構造的細部が集積装置または複数の装置の組立体に関する場合は , グループ H 1 0 H 2 9 / 8 0 に分類する。構造的細部が個々の装置に関する場合は , グループ H 1 0 H 2 0 / 8 0 に分類する。 [2 0 2 5 . 0 1]

- 29/85 ・ ・ パッケージ [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/851 ・ ・ ・ 波長変換手段 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/852 ・ ・ ・ 封緘 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/853 ・ ・ ・ ・ その形状に特徴のあるもの [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/854 ・ ・ ・ ・ その材料に特徴のあるもの , 例 . エポキシ樹脂またはシリコン樹脂 [2 0 2 5 . 0 1]
- 29/855 ・ ・ ・ 光の形状を形成する手段 , 例 . レンズ [2 0 2 5 . 0 1]

- 29/856 ・ ・ ・ ・ 反射手段 [2 0 2 5 . 0 1]
- 99/00 このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [2 0 2 5 . 0 1]